

## عنوان مقاله:

استفاده از لایه های نانومتری دی اکسید قلع به منظور افزایش سیگنال کر مغناطیسی در ساختار Cu/Co/SnO<sub>2</sub> برای کاربرد حافظه ای

## محل انتشار:

اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو (سال: 1389)

تعداد صفحات اصل مقاله: 4

## نویسندگان:

مهرداد مرادی - پژوهشگر علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

مجید قناعت شعار - پژوهشگر لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تهران

## خلاصه مقاله:

در دنیای فناوری اطلاعات ثبت و خواندن اطلاعات با سرعت بالا یکی از مهمترین بحث ها را به خود اختصاص داده است امروزه از لایه های نازک مغناطیسی به عنوان حافظه های مغناطیسی و از اثر مگنتوآپتیکی کر به عنوان ابزاری برای خواندن اطلاعات از روی آنها استفاده می شود اغلب فلزات واسطه اثرکر کوچکتر از یک درجه در دمای اتاق دارند که باعث عدم دقت در فرایند خواندن اطلاعات می شود با کوچک شدن نواحی احتمال کاهش این اثر بیشتر نیز خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که ساختار چند لایه ای Cu/Co/SnO<sub>2</sub> با توجه به ضخامت لایه دی اکسید قلع به گونه ای طراحی شود که سیگنال کر در آن افزایش یابد.

## کلمات کلیدی:

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/103955>

